EPITA / InfoS3	
NOM .	

...... Prénom :

Novembre 2022 Groupe :



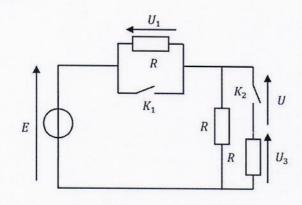
Contrôle Electronique - CORRIGE

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés. Le barème est donné à titre indicatif.

Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le verso des pages.

Exercice 1. QCM (4 points – Sans point négatif)

Soit le circuit ci-dessous :



Q1. Quelle est l'expression de U si K_1 et K_2 sont ouverts ?

$$\underbrace{a}_{-}U = \frac{E}{2}$$

$$c-U=E$$

b-
$$U = 0$$

d-
$$U = \frac{E}{3}$$

Quelle est l'expression de U si K_1 est ferméet K_2 est ouvert ? Q2.

a-
$$U = \frac{E}{2}$$

$$C-U = E$$

b-
$$U = 0$$

d-
$$U = \frac{E}{3}$$

Q3. Dans un semi-conducteur, le courant est composé :

- a- D'électrons libres uniquement
- (b-) D'électrons et de trous se déplaçant dans des sens opposés
- c- D'électrons et de trous se déplaçant dans le même sens
- d- De trous uniquement.

Dans un semi-conducteur intrinsèque, le nombre d'électrons libres est : Q4.

(a-) égal au nombre de trous

- c- plus petit que le nombre de trous
- b- plus grand que le nombre de trous d- aucun des cas précédents

- Q5. Le dopage permet d'augmenter la conductivité du semi-conducteur.
 - (a) VRAI

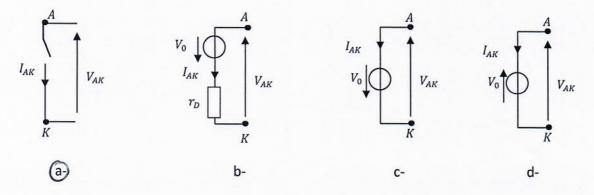
b- FAUX

- Q6. Qu'est-ce-que la thermogénération
 - a- Un dégagement de chaleur
 - 6- La création de paires Electrons/Trous sous l'effet de la température
- c- C'est un autre terme pour désigner l'effet Joule
- d- La fabrication de capteurs de température
- Q7. On utilise l'élément semi-conducteur de silicium avec 4 électrons dans la bande de valence. Si on le dope avec de l'aluminium, élément ayant 3 électrons dans sa bande de valence, quel est le type de dopage :
 - a- Dopage N

c- Dopage NP

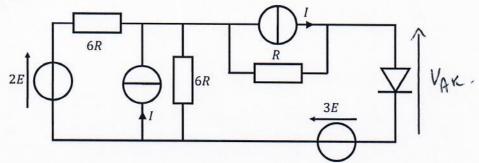
b Dopage P

- d- Aucun dopage
- Q8. Par quoi remplace-t-on la diode bloquée si on utilise le modèle réel (source de tension imparfaite)?

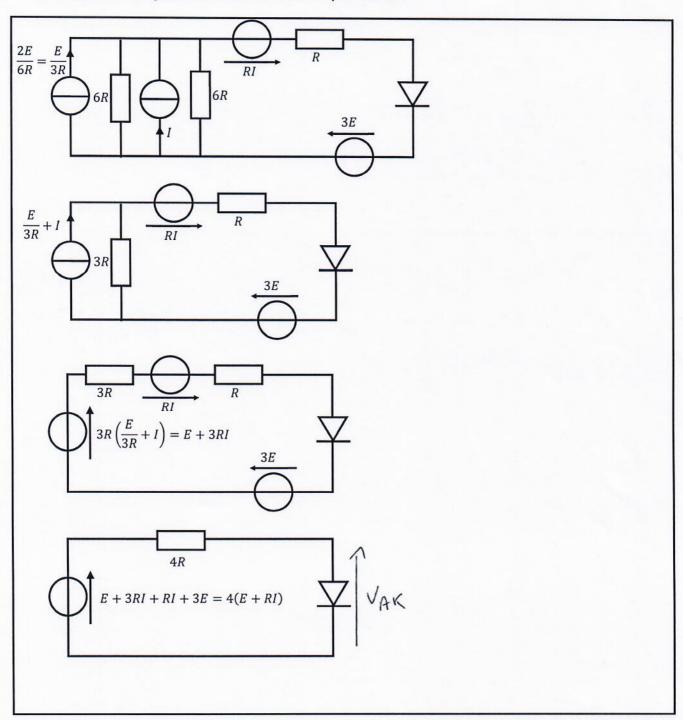


Exercice 2. Révisions SUP+Diode (5 points)

Soit le circuit ci-dessous.



1. Déterminer le générateur de Thévenin vu par la diode.



2. A quelle condition reliant E, I et R la diode sera-t-elle passante ? On utilisera le modèle à seuil (Modèle source de tension idéale).

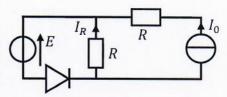
Gu soit pur la diode sera bloquée tant pur VAK (Vo. 6r, si la diode est bloquée, de tension aux bornes de 4R sera mulle (cor pas de courant).

= Si la diode est bloquée, alors VAK = 4(E+RI)

= Sa diode sera passante si 4(E+RI) > Vo

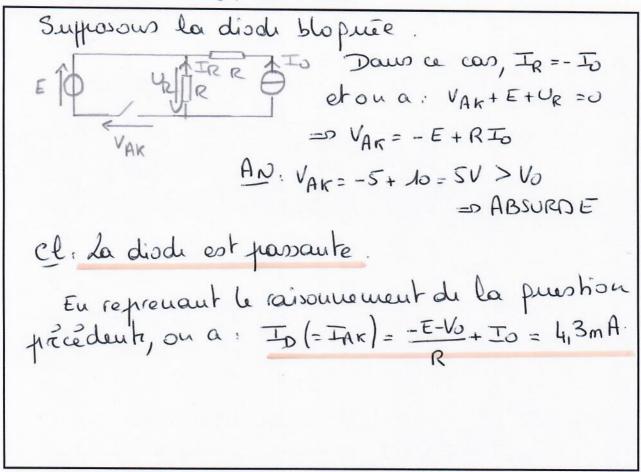
Exercice 3. Diodes (6 points)

Soit le schéma suivant : On modélisera la diode en utilisant son modèle à seuil (générateur de tension idéal) avec $V_0=0.7V$. Pour les 2 questions suivantes, vous utiliserez un raisonnement par l'absurde.



1. Si R=1 $k\Omega$, $I_0=5$ mA et E=5 V, montrer que la diode est bloquée. Déterminer alors l'intensité du courant I_R qui traverse la résistance.

2. Si R=1 $k\Omega$, $I_0=10$ mA et E=5 V, montrer que la diode est passante. Déterminer alors l'intensité du courant I_D qui traverse la diode.



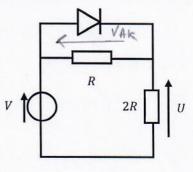
Exercice 4. Caractéristique de transfert (5 points+1)

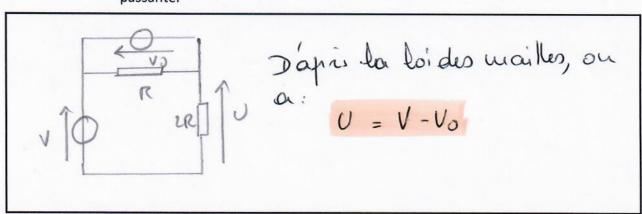
Soit le circuit suivant :

On souhaite tracer la caractéristique U = f(V).

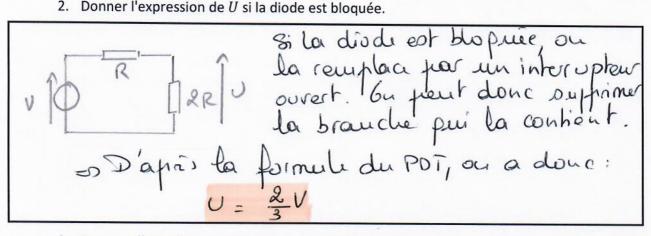
On utilisera le modèle à seuil (source de tension parfaite) pour modéliser la diode; et on appellera $V_{\mathcal{O}}$ sa tension de seuil.

 Donner l'expression de U si la diode est passante.





2. Donner l'expression de U si la diode est bloquée.



3. Pour quelles valeurs de V la diode est-elle bloquée?

La disolu est bloquie si
$$V_{AK} < V_0$$

si $V_{-U} < V_0$

si $V_{-\frac{2}{3}}V < V_0$ (cou $U_{=\frac{2}{3}}V$)

si $V < 3V_0$

4. Tracer U = f(V).

